

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-158680

(43)Date of publication of application : 12.06.2001

(51)Int.Cl.

C04B 41/88

B24B 37/04

C04B 35/626

C04B 41/85

C09K 3/14

H01L 21/304

(21)Application number : 11-340409

(71)Applicant : IBIDEN CO LTD

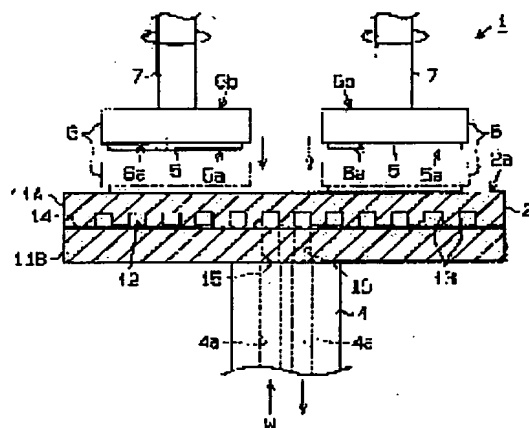
(22)Date of filing : 30.11.1999

(72)Inventor : MAJIMA KAZUTAKA  
YASUDA HIROYUKI**(54) SILICON CARBIDE-METAL COMPLEX, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, MEMBER FOR WAFER-POLISHING DEVICE AND TABLE FOR WAFER-POLISHING DEVICE**

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a silicon carbide-metal complex extremely superior in soaking properties, thermal responsibility and dimensional stability.

**SOLUTION:** This table 2 is used for wafer-polishing device 1, and comprises base materials 11A and 11B made from a porous silicon carbide sintered body. The porous silicon carbide sintered body has open pores 23 present in a structure constituted of silicon carbide crystals 21 and 22. The average particle diameter of the silicon carbide crystals 21 and 22 is  $\geq 20 \mu\text{m}$ , and the porosity and the thermal conductivity thereof are  $\leq 30\%$  and  $\geq 160 \text{ W/m.K}$  respectively. The metal of 15-50 pts.wt. based on the silicon carbide of 100 pts.wt. is impregnated therein.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.11.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision]

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-158680

(P 2 0 0 1 - 1 5 8 6 8 0 A)

(43) 公開日 平成13年6月12日 (2001. 6. 12)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード (参考)
C04B 41/88		C04B 41/88	U 3C058
B24B 37/04		B24B 37/04	A 4G001
C04B 35/626		C04B 41/85	C
41/85		C09K 3/14	550 C
C09K 3/14	550	H01L 21/304	622 F
審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全11頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願平11-340409  
(22) 出願日 平成11年11月30日 (1999. 11. 30)

(71) 出願人 000000158  
イビデン株式会社  
岐阜県大垣市神田町2丁目1番地  
(72) 発明者 馬嶋 一隆  
岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデ  
ン 株式会社大垣北工場内  
(72) 発明者 安田 裕之  
岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデ  
ン 株式会社大垣北工場内  
(74) 代理人 100068755  
弁理士 恩田 博宣 (外1名)

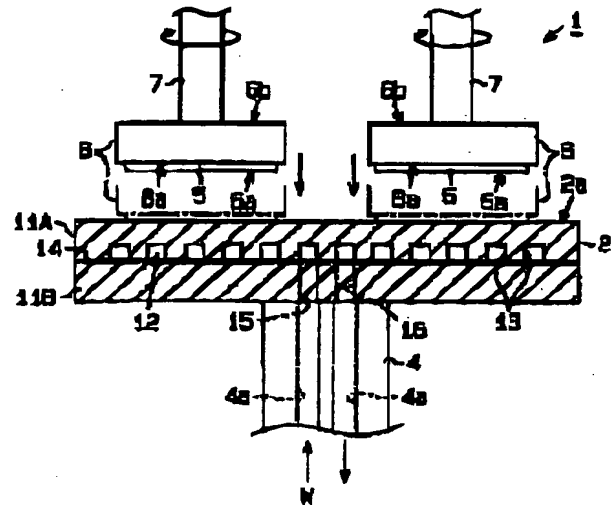
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 炭化珪素・金属複合体及びその製造方法、並びにウェハ研磨装置用部材及びウェハ研磨装置用テーブル

(57) 【要約】

【課題】 均熱性、熱応答性及び形状安定性に極めて優れた炭化珪素・金属複合体を提供すること。

【解決手段】 このテーブル2はウェハ研磨装置1に用いられるものであって、多孔質炭化珪素焼結体製の基材11A、11Bからなる。この多孔質炭化珪素焼結体では、炭化珪素結晶21、22によって構成される組織中に開放気孔23が存在している。炭化珪素結晶21、22の平均粒径は20μm以上、気孔率は30%以下、熱伝導率は160W/m・K以上である。また、炭化珪素100重量部に対して15重量部～50重量部の金属が含浸されている



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】炭化珪素結晶によって構成される多孔質組織中に開放気孔が存在し、その開放気孔中に金属が含まれている炭化珪素・金属複合体において、

前記炭化珪素結晶の平均粒径が $20\mu\text{m}$ 以上、気孔率が30%以下、熱伝導率が $160\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ 以上であり、炭化珪素100重量部に対して15重量部～50重量部の金属が含まれている炭化珪素・金属複合体。

【請求項2】炭化珪素結晶によって構成される多孔質組織中に開放気孔が存在し、その開放気孔中に金属が含まれている炭化珪素・金属複合体において、

前記炭化珪素結晶の平均粒径が $20\mu\text{m}$ ～ $100\mu\text{m}$ 、気孔率が5%～30%、熱伝導率が $160\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ 以上であり、炭化珪素100重量部に対して15重量部～50重量部の金属が含まれている炭化珪素・金属複合体。

【請求項3】炭化珪素100重量部に対して15重量部～45重量部の金属シリコンが含まれていることを特徴とする請求項1または2に記載の炭化珪素・金属複合体。

【請求項4】炭化珪素100重量部に対して20重量部～50重量部の金属アルミニウムが含まれていることを特徴とする請求項1または2に記載の炭化珪素・金属複合体。

【請求項5】平均粒径が $0.1\mu\text{m}$ ～ $1.0\mu\text{m}$ の細かい炭化珪素結晶を10体積%～50体積%含み、かつ、平均粒径が $25\mu\text{m}$ ～ $150\mu\text{m}$ の粗い炭化珪素結晶を50体積%～90体積%含むことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の炭化珪素・金属複合体。

【請求項6】炭化珪素結晶によって構成される多孔質組織中に開放気孔が存在し、その開放気孔中に炭化珪素100重量部に対して15重量部～50重量部の金属が含まれ、前記炭化珪素結晶の平均粒径が $20\mu\text{m}$ 以上、気孔率が30%以下、熱伝導率が $160\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ 以上である炭化珪素・金属複合体を製造する方法であって、平均粒径 $5\mu\text{m}$ ～ $100\mu\text{m}$ の $\alpha$ 型炭化珪素の粗粉末100重量部に対して、平均粒径 $0.1\mu\text{m}$ ～ $1.0\mu\text{m}$ の $\alpha$ 型炭化珪素の微粉末を10重量部～100重量部を配合し、これを均一に混合する工程、前記工程により得られた混合物を所定形状に成形して成形体を得る工程、前記成形体を $1700^\circ\text{C}$ ～ $2400^\circ\text{C}$ の温度範囲で焼成して焼結体を得る工程、及び前記成形体または前記焼結体に金属を含浸する工程を含むことを特徴とする炭化珪素・金属複合体の製造方法。

【請求項7】前記成形体には、炭素源となる有機物が炭素重量換算値で1重量%～10重量%配合されていることを特徴とする請求項6に記載の炭化珪素・金属複合体の製造方法。

【請求項8】ウェハ研磨装置に用いられる部材であって、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の炭化珪素・

金属複合体から構成されるウェハ研磨装置用部材。

【請求項9】ウェハ研磨装置を構成しているウェハ保持プレートの保持面に保持されている半導体ウェハが摺接される研磨面を有するテーブルにおいて、

請求項1乃至5のいずれか1項に記載の炭化珪素・金属複合体からなる基材を複数枚積層した状態で各基材同士が接合されるとともに、前記基材の接合界面に流体流路が配設されているウェハ研磨装置用テーブル。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、炭化珪素・金属複合体及びその製造方法、並びにウェハ研磨装置用部材及びウェハ研磨装置用テーブルに関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】従来、非酸化物セラミックの一種として炭化珪素(SiC)が知られている。炭化珪素焼結体は、熱伝導性、耐熱性、耐熱衝撃性、耐摩耗性、硬度、耐酸化性、耐食性等に優れるという好適な特性を有する。

【0003】ゆえに、炭化珪素焼結体は、メカニカルシールや軸受等の耐摩耗材料をはじめとして、高温炉用の耐火材、熱交換器、燃焼管等の耐熱構造材料、酸やアルカリに晒されやすいポンプ部品等の耐腐食材料など、広く利用可能な材料であるといえる。また、近年では上記の諸特性、特に高い熱伝導性に着目し、多孔質炭化珪素焼結体を半導体製造装置(例えばウェハ研磨装置等)の構成材料として利用しようとする動きがある。これに加え、多孔質炭化珪素焼結体に存在する開放気孔中に金属を含浸することによって、非含浸体よりもさらに熱伝導性に優れた炭化珪素・金属複合体を製造することも提案されている。

【0004】ウェハ研磨装置とは、半導体ウェハのデバイス形成面を研磨するためのラッピングマシンやポリッシングマシンのことを指す。この装置は、ウェハトッププレート及び炭化珪素・金属複合体製のテーブル等を備えている。テーブル内に設けられた流路には冷却水が循環される。ウェハトッププレートの保持面には、半導体ウェハが熱可塑性ワックスを用いて貼付けられる。回転するブッシュプレートに保持された半導体ウェハは、テーブルの研磨面に対して上方から押し付けられる。その結果、研磨面に半導体ウェハが摺接し、ウェハの片側面が均一に研磨される。そして、このときウェハに発生した熱は、テーブル内を伝導した後、流路を循環する冷却水により装置の外部に持ち去られるようになっている。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】ところで、炭化珪素・金属複合体には、熱を効率よく伝導するという性質があるため、内部に温度バラツキが生じにくいという利点がある。従って、かかる複合体には高い均熱性・熱応答性が付与される。また、熱応力の発生が回避されて基材が

反りにくくなる結果、形状安定性が高くなる。ところで、炭化珪素・金属複合体は炭化珪素非含浸体に比較して熱伝導率が高いというものの、現時点における熱伝導率の値は $100\text{ W/m}\cdot\text{K}\sim 150\text{ W/m}\cdot\text{K}$ 程度である。従って、よりいっそう均熱性、熱応答性、形状安定性に優れたものを実現するためには、さらなる熱伝導性の向上が必須と考えられていた。また、この複合体を前記テーブルに利用した場合についても同様に、大口径・高品質ウェハの実現のためには熱伝導性の向上が必須と考えられていた。

【0006】本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その第1の目的は、均熱性、熱応答性及び形状安定性に極めて優れた炭化珪素・金属複合体を提供することにある。第2の目的は、このような好適な複合体を確実に製造できる方法を提供することにある。さらに、第3の目的は、大口径・高品質ウェハの製造に好適なウェハ研磨装置用テーブルを提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明では、炭化珪素結晶によって構成される多孔質組織中に開放気孔が存在し、その開放気孔中に金属が含まれている炭化珪素・金属複合体において、前記炭化珪素結晶の平均粒径が $20\mu\text{m}$ 以上、気孔率が $30\%$ 以下、熱伝導率が $160\text{ W/m}\cdot\text{K}$ 以上であり、炭化珪素100重量部に対して15重量部～50重量部の金属が含まれている炭化珪素・金属複合体をその要旨とする。

【0008】請求項2に記載の発明では、炭化珪素結晶によって構成される多孔質組織中に開放気孔が存在し、その開放気孔中に金属が含まれている炭化珪素・金属複合体において、前記炭化珪素結晶の平均粒径が $20\mu\text{m}\sim 100\mu\text{m}$ 、気孔率が $5\%\sim 30\%$ 、熱伝導率が $160\text{ W/m}\cdot\text{K}$ 以上であり、炭化珪素100重量部に対して15重量部～50重量部の金属が含まれている炭化珪素・金属複合体をその要旨とする。

【0009】請求項3に記載の発明では、請求項1または2において、炭化珪素100重量部に対して15重量部～45重量部の金属シリコンが含まれているとした。請求項4に記載の発明では、請求項1または2において、炭化珪素100重量部に対して20重量部～50重量部の金属アルミニウムが含まれているとした。

【0010】請求項5に記載の発明では、請求項1乃至4のいずれか1項において、平均粒径が $0.1\mu\text{m}\sim 1.0\mu\text{m}$ の細かい炭化珪素結晶を10体積%～50体積%含み、かつ、平均粒径が $25\mu\text{m}\sim 65\mu\text{m}$ の粗い炭化珪素結晶を50体積%～90体積%含むこととした。

【0011】請求項6に記載の発明では、炭化珪素結晶によって構成される多孔質組織中に開放気孔が存在し、その開放気孔中に炭化珪素100重量部に対して15重

量部～50重量部の金属が含まれ、前記炭化珪素結晶の平均粒径が $20\mu\text{m}$ 以上、気孔率が $30\%$ 以下、熱伝導率が $160\text{ W/m}\cdot\text{K}$ 以上である炭化珪素・金属複合体を製造する方法であって、平均粒径 $5\mu\text{m}\sim 100\mu\text{m}$ の $\alpha$ 型炭化珪素の粗粉末100重量部に対して、平均粒径 $0.1\mu\text{m}\sim 1.0\mu\text{m}$ の $\alpha$ 型炭化珪素の微粉末を10重量部～100重量部を配合し、これを均一に混合する工程、前記工程により得られた混合物を所定形状に成形して成形体を得る工程、前記成形体を $1700^\circ\text{C}\sim 2400^\circ\text{C}$ の温度範囲で焼成して焼結体を得る工程、及び前記成形体または前記焼結体に金属を含浸する工程を含むことを特徴とする炭化珪素・金属複合体の製造方法をその要旨とする。

【0012】請求項7に記載の発明は、請求項6において、前記成形体には、炭素源となる有機物が炭素重量換算値で1重量%～10重量%配合されているとした。請求項8に記載の発明では、ウェハ研磨装置に用いられる部材であって、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の炭化珪素・金属複合体から構成されるウェハ研磨装置用部材をその要旨とする。

【0013】請求項9に記載の発明では、ウェハ研磨装置を構成しているウェハ保持プレートの保持面に保持されている半導体ウェハが摺接される研磨面を有するテーブルにおいて、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の炭化珪素・金属複合体からなる基材を複数枚積層した状態で各基材同士が接合されるとともに、前記基材の接合界面に流体流路が配設されているウェハ研磨装置用テーブルをその要旨とする。

【0014】以下、本発明の「作用」について説明する。請求項1～5に記載の発明によると、多孔質組織を構成する炭化珪素結晶の平均粒径が、 $20\mu\text{m}$ 以上という比較的大きな値に設定されている。熱が結晶の内部を伝導する効率は、熱が結晶間を伝導する効率に比べて一般に高いため、平均粒径が大きいほど熱伝導率が高くなる。また、多孔質組織の気孔率が $30\%$ 以下という小さい値に設定されていることも、熱伝導性の向上に寄与している。即ち、気孔率が小さくなると多孔質組織内における空隙が減る結果、熱が伝導しやすくなるからである。さらに、炭化珪素100重量部に対して15重量部～50重量部の金属が含まれていることも、熱伝導率の向上に寄与している。

【0015】このため、全体としての熱伝導率が $160\text{ W/m}\cdot\text{K}$ よりもかなり低い値である従来の複合体に比べて、内部に温度バラツキが生じにくくなる。その結果、複合体に極めて高い均熱性及び熱応答性が付与される。また、熱応力の発生が確実に回避されて基材が反りにくくなる結果、複合体に極めて高い形状安定性が付与される。

【0016】この場合、炭化珪素結晶の平均粒径が $20\mu\text{m}$ 未満であったり、気孔率が $30\%$ を超えるものであ

ると、含浸を行ったとしても熱伝導率を $160\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ 以上の高い値にすることが困難になる。従って、均熱性、熱応答性及び形状安定性の向上を十分に達成することができなくなる。なお、熱伝導率の値は $160\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ 以上であることが必要であり、さらには $180\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}\sim 280\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ であることが好ましく、 $200\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}\sim 260\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ であることが特に好ましい。

【0017】炭化珪素結晶の平均粒径は、 $20\mu\text{m}\sim 100\mu\text{m}$ に設定されることが好ましく、 $30\mu\text{m}\sim 90\mu\text{m}$ に設定されることがより好ましく、 $40\mu\text{m}\sim 70\mu\text{m}$ に設定されることが最も好ましい。平均粒径が大きくなりすぎると、複合体が過度に緻密化してしまうおそれがある。

【0018】開放気孔の気孔率は、 $5\%\sim 30\%$ に設定されることが好ましく、 $10\%\sim 25\%$ に設定されることがより好ましく、 $10\%\sim 20\%$ に設定されることが最も好ましい。

【0019】また、複合体は、平均粒径が $0.1\mu\text{m}\sim 1.0\mu\text{m}$ の細かい炭化珪素結晶（以下、細結晶という）を $10\text{体積}\%\sim 50\text{体積}\%$ 含み、かつ、平均粒径が $25\mu\text{m}\sim 150\mu\text{m}$ の粗い炭化珪素結晶（以下、粗結晶という）を $50\text{体積}\%\sim 90\text{体積}\%$ 含むものであることが好ましい。

【0020】上記のように、細結晶と粗結晶とが適宜の比率で含まれる複合体の場合、粗結晶間に形成される空隙が細結晶で埋まった状態となりやすく、実質的な空隙の比率が小さくなる。その結果、複合体の熱抵抗がよりいっそう小さくなり、このことが熱伝導性の向上に大きく貢献しているものと考えられる。

【0021】細結晶の平均粒径は、 $0.1\mu\text{m}\sim 1.0\mu\text{m}$ に設定されることがよく、 $0.2\mu\text{m}\sim 0.9\mu\text{m}$ に設定されることがより好ましく、 $0.3\mu\text{m}\sim 0.7\mu\text{m}$ に設定されることが最も好ましい。細結晶の平均粒径を極めて小さくしようとすると、高価な微粉末の使用が必要となるため、材料コストの高騰につながるおそれがある。逆に、細結晶の平均粒径が大きくなりすぎると、粗結晶間に形成される空隙を十分に埋めることができなくなり、複合体の熱抵抗を十分に低減できなくなるおそれがある。

【0022】複合体において細結晶は、 $10\text{体積}\%\sim 50\text{体積}\%$ 含まれることがよく、 $15\text{体積}\%\sim 40\text{体積}\%$ 含まれることがより好ましく、 $20\text{体積}\%\sim 40\text{体積}\%$ 含まれることが最も好ましい。細結晶の含有比率が小さくなりすぎると、粗結晶間に形成される空隙を埋めるのに十分な量の細結晶が確保されにくくなり、複合体の熱抵抗を確実に低減できなくなるおそれがある。逆に、細結晶の含有比率が大きくなりすぎると、前記空隙を埋める細結晶がむしろ余剰となり、本来熱伝導性の向上に必要な程度の粗結晶が確保されなくなる。従って、かえっ

て複合体の熱抵抗が大きくなるおそれがある。

【0023】さらに、複合体において粗結晶の平均粒径は、 $25\mu\text{m}\sim 150\mu\text{m}$ に設定されることがよく、 $40\mu\text{m}\sim 100\mu\text{m}$ に設定されることがより好ましく、 $60\mu\text{m}\sim 80\mu\text{m}$ に設定されることが最も好ましい。粗結晶の平均粒径を極めて小さくしようとすると、前記細粒子との粒径差が小さくなる結果、細結晶と粗結晶との混合による熱抵抗低減効果を期待できなくなるおそれがある。逆に、粗結晶の平均粒径が大きくなりすぎると、粗結晶間に形成される個々の空隙が大きくなることから、たとえ十分な量の細結晶があったとしても当該空隙を十分に埋めることは困難になる。よって、複合体の熱抵抗を十分に低減できなくなるおそれがある。

【0024】複合体において粗結晶は、 $50\text{体積}\%\sim 90\text{体積}\%$ 含まれることがよく、 $60\text{体積}\%\sim 85\text{体積}\%$ 含まれることがより好ましく、 $60\text{体積}\%\sim 80\text{体積}\%$ 含まれることが最も好ましい。粗結晶の含有比率が小さくなりすぎると、本来熱伝導率の向上に必要な程度の粗結晶が確保されなくなり、かえって複合体の熱抵抗が大きくなるおそれがある。逆に、粗結晶の含有比率が大きくなりすぎると、相対的に細結晶の含有比率が小さくなってしまい、粗結晶間に形成される空隙を十分に埋めることができなくなる。よって、複合体の熱抵抗を確実に低減できなくなるおそれがある。

【0025】ところで本発明では、炭化珪素 $100$ 重量部に対して $15$ 重量部 $\sim 50$ 重量部の金属が含浸されている必要がある。金属含浸を行うと、金属が焼結体の開放気孔内に埋まり込むことによって見かけ上は緻密体となり、結果として熱伝導性及び強度の向上が図られるからである。

【0026】上記の含浸用金属としては、特に金属シリコンを選択することがよい。金属シリコンは炭化珪素との馴染みがよい物質であることに加え、それ自体が高い熱伝導率を有している。ゆえに、金属シリコンを焼結体の開放気孔内に充填することによって、熱伝導性及び強度の向上を確実に達成することができるからである。

【0027】この場合、金属シリコンは、炭化珪素 $100$ 重量部に対して $15$ 重量部 $\sim 45$ 重量部含浸されていることがよく、さらには $15$ 重量部 $\sim 30$ 重量部含浸されていることが好ましい。含浸量が $15$ 重量部未満であると、開放気孔を十分に埋めることができなくなり、複合体の熱抵抗を確実に低減できなくなるおそれがある。逆に、含浸量が $30$ 重量部を超えるようになると、結晶部分の比率が相対的に低下してしまう結果、場合によってはかえって熱伝導率が低下してしまう可能性がある。

【0028】なお、金属シリコン以外のもの、例えば金属アルミニウムを選択した場合には、それが炭化珪素 $100$ 重量部に対して $20$ 重量部 $\sim 50$ 重量部含浸されていることがよい。含浸量が上記範囲を逸脱すると、熱伝導率の低下を来すおそれがあるからである。

【0029】請求項6に記載の発明によると、本発明の多孔質炭化珪素焼結体は、上記のごとく、粗粉末に微粉末を所定割合で配合して混合する材料調製工程、成形工程及び焼成工程、金属含浸工程を経て製造される。金属含浸工程は、焼成工程後に行われてもよいほか、焼成工程前に行われてもよい。

【0030】前記材料調製工程においては、平均粒径 $5\mu\text{m}$ ～ $100\mu\text{m}$ の $\alpha$ 型炭化珪素の粗粉末100重量部に対して、平均粒径 $0.1\mu\text{m}$ ～ $1.0\mu\text{m}$ の $\alpha$ 型炭化珪素の微粉末を10重量部～100重量部を配合し、これを均一に混合することを行う。

【0031】 $\alpha$ 型炭化珪素の粗粉末の平均粒径は、 $5\mu\text{m}$ ～ $100\mu\text{m}$ に設定されることがよく、 $15\mu\text{m}$ ～ $75\mu\text{m}$ に設定されることがより好ましく、 $25\mu\text{m}$ ～ $60\mu\text{m}$ に設定されることが最も好ましい。 $\alpha$ 型炭化珪素の粗粉末の平均粒径が $5\mu\text{m}$ 未満になると、異常粒成長を抑制する効果が低くなるおそれがある。逆に、 $\alpha$ 型炭化珪素の粗粉末の平均粒径が $60\mu\text{m}$ を超えると、成形性が悪化することに加え、得られる複合体の強度が低くなるおそれがある。

【0032】 $\alpha$ 型炭化珪素の微粉末の平均粒径は、 $0.1\mu\text{m}$ ～ $1.0\mu\text{m}$ に設定されることがよく、 $0.1\mu\text{m}$ ～ $0.8\mu\text{m}$ に設定されることがより好ましく、 $0.2\mu\text{m}$ ～ $0.5\mu\text{m}$ に設定されることが最も好ましい。 $\alpha$ 型炭化珪素の微粉末の平均粒径が $0.1\mu\text{m}$ 未満になると、粒成長の制御が困難になることに加え、材料コストの高騰が避けられなくなる。逆に、 $\alpha$ 型炭化珪素の微粉末の平均粒径が $1.0\mu\text{m}$ を超えると、粗結晶間に形成される空隙が埋まりにくくなるおそれがある。なお、微粉末として $\alpha$ 型を選択した理由は、 $\beta$ 型に比べて熱伝導率がいくぶん高くなる傾向があるからである。

【0033】前記微粉末の配合量は、10重量部～100重量部であることがよく、15重量部～65重量部であることがより好ましく、20重量部～60重量部であることが最も好ましい。微粉末の配合量が少なすぎると、粗結晶間に形成される空隙を埋めるのに十分な量の細結晶が確保されにくくなり、複合体の熱抵抗が十分に低減できなくなるおそれがある。また、 $20\mu\text{m}$ 以上という所望の気孔径を得るために焼成温度を極めて高温に設定する必要が生じ、コスト的に不利となる。逆に、微粉末の配合量が多すぎると、熱伝導性の向上に必要な程度の粗結晶が確保されなくなる結果、複合体の熱抵抗が大きくなるおそれがある。また、強度に優れた複合体を得ることも困難になる。

【0034】上記の材料調製工程においては、前記2種の粉末とともに、成形用バインダや分散溶媒が必要に応じて配合される。そして、これを均一に混合・混練して粘度を適宜調製することにより、まず原料スラリーが得られる。なお、原料スラリーを混合する手段としては、振動ミル、アトライター、ボールミル、コロイドミル、

高速ミキサー等がある。混合された原料スラリーを混練する手段としては、例えばニーダー等がある。

【0035】成形用バインダとしては、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリエチレングリコール、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂等がある。成形用バインダの配合割合は、一般に炭化珪素粉末の合計100重量部に対し、1重量部～10重量部の範囲であることが好適である。この比率が1重量部未満であると、得られる成形体の強度が不十分となり、取扱性が悪くなる。逆に、この比率が10重量部を超えるものであると、乾燥等によって成形用バインダを除去する際に成形体にクラックが生じやすくなり、歩留まりが悪化してしまう。

【0036】分散溶媒としては、ベンゼン、シクロヘキサン等の有機溶剤、メタノール等のアルコール、水等が使用可能である。また、上記原料スラリー中には、さらに炭素源となる有機物が炭素重量換算値で1重量%～10重量%、特に6重量%～9重量%配合されていることがよい。即ち、前記有機物に由来する炭素が焼結体の炭化珪素の表面に付着することにより、含浸してきた金属シリコンと炭素とが反応し、そこにあらたに炭化珪素を生成する。従って、そこに強いネッキングが起き、これにより熱伝導性及び強度の向上が図られるからである。

【0037】ここで、成形体における前記有機物の分量が少なすぎると、焼結体表面を覆う炭化珪素膜が厚くなり、焼結体側に金属シリコンが入りにくくなる結果、そこにあらたに炭化珪素が生成しにくくなるおそれがある。

【0038】逆に、成形体における前記有機物の分量が多すぎると、例えば樹脂を選択した場合において、成形時の離形性が悪化するおそれがある。また、炭化珪素の焼結が阻害される結果、強度低下を来すおそれがある。

【0039】前記有機物としては、例えばフェノールレジン、カーボンブラック、アセチレンブラック、ピッチ、タールなどがある。このなかでもフェノールレジン、ボールミルを用いた場合に原料を均一に混合できるという点で有利である。

【0040】次いで、前記原料スラリーを用いて炭化珪素の顆粒が形成される。炭化珪素粉末を顆粒化する方法としては、噴霧乾燥による顆粒化法（いわゆるスプレードライ法）のように、従来からある汎用技術を用いることができる。即ち、原料スラリーを高温状態に維持した容器内へ噴霧し、急速に乾燥を行なう方法などが適用可能である。

【0041】ここで、顆粒水分率は0.1重量%～2.0重量%であることがよく、0.2重量%～0.9重量%であることがさらによい。その理由は、顆粒水分率が上記範囲内であると、成形体密度及び焼結体密度が高く



なる結果、熱伝導率が高くなるからである。顆粒水分率が0.1重量%未満であると、成形体密度及び焼結体密度が十分に高くなり、熱伝導率が高くなりにくくなる。逆に、顆粒水分率が2.0重量%を超えると、乾燥時に成形体にクラックが入りやすくなるおそれがあり、歩留まりの悪化につながってしまう。

【0042】続く成形工程においては、材料調製工程により得られた混合物からなる顆粒を所定形状に成形して成形体を作製する。その際の成形圧力は、 $1.0 \text{ t/cm}^2 \sim 1.5 \text{ t/cm}^2$ であることがよく、 $1.1 \text{ t/cm}^2 \sim 1.4 \text{ t/cm}^2$ であることがさらによい。その理由は、成形体密度及び焼結体密度が高くなる結果、熱伝導率が高くなるからである。成形圧力が $1.0 \text{ t/cm}^2$ 未満であると、成形体密度及び焼結体密度が十分に高くなり、熱伝導率が高くなりにくくなる。逆に、 $1.5 \text{ t/cm}^2$ よりも大きな圧力で成形を行った場合、成形体密度等を十分に高くすることができる反面、専用のプレス装置が必要となり、設備コストの高騰や製造の困難化を招く結果となる。

【0043】また、成形体の密度は、 $2.0 \text{ g/cm}^3$ 以上に設定されることがよく、特に $2.2 \text{ g/cm}^3 \sim 2.7 \text{ g/cm}^3$ に設定されることが好ましい。その理由は、成形体の密度が小さすぎると、炭化珪素粒子相互の結合箇所が少なくなるからである。よって、得られる多孔質体の強度が低くなり、取扱性が悪くなる。逆に、成形体の密度を大きくしようとすると、上記のごとく専用のプレス装置が必要となり、設備コストの高騰や製造の困難化を招く結果となる。

【0044】続く焼成工程においては、成形工程によって得られた成形体を $1700^\circ\text{C} \sim 2400^\circ\text{C}$ の温度範囲で、好ましくは $2000^\circ\text{C} \sim 2400^\circ\text{C}$ の温度範囲で、特に好ましくは $2000^\circ\text{C} \sim 2300^\circ\text{C}$ の温度範囲で焼成して焼結体を作製する。

【0045】焼成温度が低すぎると、炭化珪素粒子同士を結合するネック部を十分に発達させることが困難になり、高熱伝導率及び高強度を達成できなくなる場合がある。逆に、焼成温度が高すぎると、炭化珪素の熱分解が始まる結果、焼結体の強度低下を来してしまう。しかも、焼成炉に投じる熱エネルギー量が増大する結果、コスト的に不利となる。

【0046】また、焼成時において焼成炉の内部は、例えばアルゴン、ヘリウム、ネオン、窒素、水素及び一酸化炭素の中から選択される少なくとも一種からなるガス雰囲気（即ち非酸化性雰囲気、不活性雰囲気）に保たれるべきである。なお、このとき焼成炉内を真空状態にしてもよい。

【0047】さらに焼成時においては、ネック部の成長を促進させるために、成形体からの炭化珪素の揮散を抑制することが有利である。成形体からの炭化珪素の揮散を抑制する方法としては、外気の侵入を遮断可能な耐熱

性の容器内に成形体を装入することが有効である。前記耐熱性の容器の形成材料としては、黒鉛または炭化珪素が好適である。

【0048】続く金属含浸工程では、以下のようにして前記焼結体（即ち未含浸の複合体）に金属を含浸する。例えば、金属シリコンを含浸するような場合、前もって焼結体に炭素質物質を含浸することが好ましい。このような炭素質物質としては、例えばフルフルアル樹脂、フェノール樹脂、リグニンスルホン酸塩、ポリビニルアルコール、コーンスターチ、樹蜜、コールタールピッチ、アルギン酸塩のような各種有機物質が使用可能である。なお、カーボンブラック、アセチレンブラックのような熱分解炭素も同様に使用可能である。

【0049】前記炭素質物質をあらかじめ含浸する理由は、焼結体の開放気孔の表面に新たな炭化珪素の膜が形成されるため、これによって溶融シリコンと多孔質体との結合が強固なものになるからである。また、炭素質物質の含浸によって、焼結体の強度も強くなるからである。

【0050】また、金属シリコンを開放気孔中へ充填する方法としては、例えば金属シリコンを加熱溶融させて含浸するという方法がある。また、微粉化した金属シリコンを分散媒液中に分散させ、この分散液を多孔質体に含浸させて乾燥した後、金属シリコンの溶融温度以上に加熱するという方法も適用可能である。

【0051】もっとも金属含浸工程は、成形体に対して、言いかえると焼成工程の前に行われてもよい。この方法によると、得られる製品の品質は若干劣る反面、省電力化が図られることで低コスト化を達成することができる。

【0052】そして、以上の各工程を実施すれば、均熱性、熱応答性及び形状安定性に極めて優れた炭化珪素・金属複合体を確実に製造することができる。請求項8に記載の発明によると、研磨面に対して半導体ウェハが回転しながら摺接する結果、半導体ウェハの片側面が前記研磨面によって均一に研磨される。上記のテーブルは、均熱性、熱応答性及び形状安定性に極めて優れた複合体からなるため、研磨時に半導体ウェハに与える熱等の影響が最小限に抑えられる。よって、本発明のテーブルによれば、大口径・高品質ウェハを確実に製造することができる。

【0053】

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した一実施形態のウェハ研磨装置1を図1～図4に基づき詳細に説明する。

【0054】図1には、本実施形態のウェハ研磨装置1が概略的に示されている。同ウェハ研磨装置1を構成しているテーブル2は円盤状である。テーブル2の上面は、半導体ウェハ5を研磨するための研磨面2aになっている。この研磨面2aには図示しない研磨クロスが貼

り付けられている。本実施形態のテーブル2は、冷却ジャケットを用いることなく、円柱状をした回転軸4の上端面に対して水平にかつ直接的に固定されている。従って、回転軸4を回転駆動させると、その回転軸4とともにテーブル2が一体的に回転する。

【0055】図1に示されるように、このウェハ研磨装置1は、複数(図1では図示の便宜上2つ)のウェハ保持プレート6を備えている。プレート6の形成材料としては、例えばガラスや、アルミナ等のセラミックス材料や、ステンレス等の金属材料などが採用される。各ウェハ保持プレート6の片面(非保持面6b)の中心部には、10 プッシュ棒7が固定されている。各プッシュ棒7はテーブル2の上方に位置するとともに、図示しない駆動手段に連結されている。各プッシュ棒7は各ウェハ保持プレート6を水平に支持している。このとき、保持面6aはテーブル2の研磨面2aに対向した状態となる。また、各プッシュ棒7はウェハ保持プレート6とともに回転することができるばかりでなく、所定範囲だけ上下動することができる。プレート6側を上下動させる方式に代え、テーブル2側を上下動させる構造を採用しても構わな

い。ウェハ保持プレート6の保持面6aには、半導体ウェハ5が例えば熱可塑性ワックス等を用いて貼着される。半導体ウェハ5は、保持面6aに対して真空引きによりまたは静電的に吸着されてもよい。このとき、半導体ウェハ5における被研磨面5aは、テーブル2の研磨面2a側を向いている必要がある。

【0056】次に、テーブル2の構成について詳細に説明する。図1、図2に示されるように、本実施形態のテーブル2は、2枚の炭化珪素・金属複合体製の基材11A、11Bからなる積層セラミックス構造体である。上側基材11Aの裏面には、流体流路である冷却水路12の一部を構成する溝13が所定パターン状に形成されている。2枚の基材11A、11B同士は、銀ロウ材層14を介して互いに接合されることにより、一体化されている。その結果、基材11A、11Bの接合界面に前記水路12が形成される。下側基材11Bの略中心部には、貫通孔15が形成されている。これらの貫通孔15は、回転軸4内に設けられた流路4aと、前記水路12とを連通させている。

【0057】水路12の一部を構成する溝13は、上側基材11Aの裏面を生加工後かつ焼成前に研削加工することにより形成された研削溝である。溝13の深さは3mm~10mm程度に、幅は5mm~20mm程度にそれぞれ設定されることがよい。

【0058】以下、本実施形態をより具体化したいくつかの実施例を紹介する。

〔実施例1〕実施例1の作製においては、出発材料として、平均粒径30 $\mu$ mの $\alpha$ 型炭化珪素の粗粉末(＃400)と、平均粒径0.3 $\mu$ mの $\alpha$ 型炭化珪素の微粉末(GMF-15H2)とを準備した。そして、前記粗粉

末100重量部に対して、前記微粉末を30重量部を配合し、これを均一に混合した。

【0059】この混合物100重量部に対し、ポリビニルアルコール5重量部、フェノールレジン3重量部、水50重量部を配合した後、ボールミル中にて5時間混合することにより、均一な混合物を得た。この混合物を所定時間乾燥して水分をある程度除去した後、その乾燥混合物を適量採取しかつ顆粒化した。このとき、顆粒の水分率を約0.8重量%になるように調節した。次いで、10 前記混合物の顆粒を、金属製押し型を用いて1.3t/cm<sup>2</sup>のプレス圧力で成形した。得られた円盤状の生成形体(50mm $\phi$ 、5mm $t$ )の密度は2.6g/cm<sup>3</sup>であった。

【0060】続いて、後に上側基材11Aとなるべき成形体の底面を研削加工することにより、深さ5mmかつ幅10mmの溝13を底面のほぼ全域に形成した。次いで、黒鉛製ルツボに前記生成形体を装入し、タンマン型焼成炉を使用してその焼成を行なった。焼成は1気圧のアルゴンガス雰囲気中において実施した。また、焼成時20 においては10℃/分の昇温速度で最高温度である2200℃まで加熱し、その後はその温度で4時間保持することとした。

【0061】次いで、得られた多孔質焼結体にフェノール樹脂(炭化率30重量%)をあらかじめ真空含浸し、かつ乾燥した。その後、前記多孔質焼結体の表面に、金属シリコンを含むスラリーをコーティングした。ここでは前記スラリーとして、平均粒径が20 $\mu$ m、純度が99.9999重量%以上の金属シリコン粉末100重量部と、5%アクリル酸エステル・ベンゼン溶液60重量部とが混合されたものを用いた。そして、金属シリコンをコーティングした多孔質焼結体をアルゴンガス気流中で450℃/時間の昇温速度で加熱し、最高温度1450℃で約1時間保持した。このような処理により金属シリコンを多孔質焼結体中へ浸透させて、炭化珪素・金属複合体を得た。なお、ここでは炭化珪素100重量部に対する金属シリコンの含浸量を、30重量部に設定した。

【0062】得られた炭化珪素・金属複合体製の基材11A、11Bでは、多孔質組織における開放気孔の気孔率20 率が20%、全体としての熱伝導率が210W/m<sup>2</sup>・K、全体としての密度が3.0g/cm<sup>3</sup>であった。また、炭化珪素結晶の平均粒径は30 $\mu$ mであった。具体的には、平均粒径が1.0 $\mu$ mの細結晶を20体積%含み、かつ、平均粒径が40 $\mu$ mの粗結晶を80体積%含んでいた。なお、参考のため、図4(c)に実施例1における粒度分布のグラフを示す。

【0063】続いて、従来公知の手法による面出し加工を行った後、銀ロウ材を用いて2枚の基材11A、11Bを接合して一体化した。さらに、上側基材11Aの表面に研削加工を施すことにより、最終的に、半導体ウェ

ハ5の研磨に通した面粗度の研磨面2aを有するテーブル2を完成した。

【0064】このようにして得られた実施例1のテーブル2を上記各種の研磨装置1にセットし、水路12内に冷却水Wを常時循環させつつ、各種サイズの半導体ウェハ5の研磨を行なった。そして、各種の研磨装置1による研磨を経て得られた半導体ウェハ5を観察したところ、ウェハサイズの如何を問わず、ウェハ5には傷が付いていなかった。また、ウェハ5に大きな反りが生じるようなこともなかった。つまり、本実施例のテーブル2を用いた場合、極めて大口径・高品質な半導体ウェハ5が得られることがわかった。

【0065】なお、図3は実施例1のテーブル2を拡大して概念的に示した断面図である。このテーブル2を構成する炭化珪素・金属複合体は、細結晶21と粗結晶22とを含んでいる。粗結晶22間に形成される空隙は、細結晶21でほぼ埋まった状態となっている。従って、実質的な空隙の比率、つまり開放気孔23の気孔率はかなり小さいものとなっていることが把握できる。これに加えて、残っている空隙には金属シリコン24が埋まり込んだ状態となっている。

【実施例2】実施例2の作製においては、平均粒径35 $\mu\text{m}$ の $\alpha$ 型炭化珪素の粗粉末（#360）を用いるとともに、前記粗粉末100重量部に対して、前記微粉末を40重量部を配合し、これを均一に混合した。それ以外の条件については、基本的に実施例1と同様にした。

【0066】その結果、得られた炭化珪素・金属複合体製の基材11A、11Bの多孔質組織の開放気孔の気孔率は17%、全体の熱伝導率は220W/m $\cdot$ K、密度は3.0g/cm<sup>3</sup>であった。また、炭化珪素結晶の平均粒径は36 $\mu\text{m}$ であった。具体的には、平均粒径が1.0 $\mu\text{m}$ の細結晶を20体積%含み、かつ、平均粒径が45 $\mu\text{m}$ の粗結晶を80体積%含んでいた。なお、参考のため、図4(b)に実施例2における粒度分布のグラフを示す。

【0067】実施例1と同じ手順でテーブル2を完成させた後、それを上記各種の研磨装置1にセットし、各種サイズの半導体ウェハ5の研磨を行なったところ、前記実施例1とほぼ同様の優れた結果が得られた。

【実施例3】実施例3の作製においては、平均粒径57 $\mu\text{m}$ の $\alpha$ 型炭化珪素の粗粉末（#240）を用いるとともに、前記粗粉末100重量部に対して、前記微粉末を40重量部を配合し、これを均一に混合した。それ以外の条件については、基本的に実施例1と同様にした。

【0068】その結果、得られた炭化珪素・金属複合体製の基材11A、11Bの開放気孔の気孔率は15%、熱伝導率は230W/m $\cdot$ K、密度は3.1g/cm<sup>3</sup>であった。また、炭化珪素結晶の平均粒径は65 $\mu\text{m}$ であった。具体的には、平均粒径が1.0 $\mu\text{m}$ の細結晶を20体積%含み、かつ、平均粒径が80 $\mu\text{m}$ の粗結晶を

80体積%含んでいた。なお、参考のため、図4(a)に実施例3における粒度分布のグラフを示す。

【0069】実施例1と同じ手順でテーブル2を完成させた後、それを上記各種の研磨装置1にセットし、各種サイズの半導体ウェハ5の研磨を行なったところ、前記実施例1とほぼ同様の優れた結果が得られた。

【比較例】比較例の作製においては、平均粒径10 $\mu\text{m}$ の $\alpha$ 型炭化珪素の粗粉末を用いるとともに、前記粗粉末100重量部に対して、平均粒径0.7 $\mu\text{m}$ の $\alpha$ 型炭化珪素の微粉末を45重量部を配合し、これを均一に混合した。それ以外の条件については、基本的に実施例1と同様にした。

【0070】この混合物100重量部に対し、ポリビニルアルコール5重量部、水50重量部を配合した後、ボールミル中にて5時間混合することにより、均一な混合物を得た。この混合物を所定時間乾燥して水分をある程度除去した後、その乾燥混合物を適量採取し、かつ顆粒化した。次いで、前記混合物の顆粒を、金属製押し型を用いて0.6t/cm<sup>2</sup>のプレス圧力で成形した。得られた円盤状の生成形体の密度は2.0g/cm<sup>3</sup>であった。この後、実施例1と同じ条件にて金属シリコンの含浸を行った。

【0071】続いて、後に上側基材11Aとなるべき成形体の底面を研削加工することにより、深さ5mmかつ幅10mmの溝13を底面のほぼ全域に形成した。次いで、黒鉛製ルツボに前記生成形体を装入し、タンマン型焼成炉を使用してその焼成を行なった。焼成は1気圧のアルゴンガス雰囲気中において実施した。また、焼成時においては10℃/分の昇温速度で最高温度である1700℃まで加熱し、その後はその温度で4時間保持することとした。

【0072】その結果、得られた炭化珪素・金属複合体製の基材11A、11Bの多孔質組織の開放気孔の気孔率は38%、熱伝導率は130W/m $\cdot$ K、密度は2.8g/cm<sup>3</sup>であった。また、炭化珪素結晶の平均粒径は10 $\mu\text{m}$ であった。

【0073】従って、本実施形態の前記各実施例によれば以下のような効果を得ることができる。

(1) 各実施例のテーブル2を構成する複合体では、いずれも炭化珪素結晶の平均粒径が20 $\mu\text{m}$ ~100 $\mu\text{m}$ 、多孔質組織の気孔率が5%~30%、全体としての熱伝導率が160W/m $\cdot$ K以上になっている。また、炭化珪素100重量部に対して15重量部~45重量部の金属シリコンが含浸されている。

【0074】しかも、これらの複合体は、いずれも平均粒径が0.1 $\mu\text{m}$ ~1.0 $\mu\text{m}$ の細結晶を10体積%~50体積%含み、かつ、平均粒径が25 $\mu\text{m}$ ~150 $\mu\text{m}$ の粗結晶を50体積%~90体積%含んでいる。

【0075】ゆえに、熱伝導率の値がいずれも160W/m $\cdot$ Kを超えるものとなり、テーブル2に極めて高い

熱伝導性が付与される。このため、従来品に比べて複合体内部に温度バラツキが生じにくくなる。その結果、複合体に極めて高い均熱性及び熱応答性が付与される。また、熱応力の発生が確実に回避されて基材 11A、11B が反りにくくなる結果、複合体に極めて高い形状安定性が付与される。そして、これによりウェハ 5 の大口径化・高品質化を確実に達成することができるようになる。

【0076】(2) このテーブル 2 の場合、基材 11A、11B の接合界面に存在する水路 12 に冷却水 W を流すことができる。そのため、半導体ウェハ 5 の研磨時に発生した熱をテーブル 2 から直接かつ効率よく逃がすことができ、しかも温度制御を細かく行うことができる。よって、冷却ジャケットにテーブル 2 を載せて間接的に冷却を行う従来装置に比べ、テーブル 2 内の温度バラツキが極めて小さくなり、均熱性及び熱応答性も格段に向上する。ゆえに、この装置 1 によれば、ウェハ 5 が熱による悪影響を受けにくくなり、ウェハ 5 の大口径化に対応することができるようになる。しかも、ウェハ 5 を高い精度で研磨することが可能となるため、高品質化にも対応することができるようになる。

【0077】なお、本発明の実施形態は以下のように変更してもよい。

・ 基材 11A、11B 同士は、ロウ材に代表される金属系接合材を用いて接合されてもよいほか、樹脂からなる接着剤（例えばエポキシ樹脂等）を用いて接合されてもよい。

【0078】・ 基材 11A、11B 同士は、必ずしもロウ材層 14 を介して接合されていなくてもよく、例えばロウ材層 14 を省略する代わりに、基材 11A、11B 同士をボルトとナットとの締結によって一体化しても構わない。

【0079】・ 焼結体に含浸される含浸用金属は、実施形態に示した金属シリコンのみに限定されることはない。例えば、アルミニウム、金、銀、銅、チタン等といった、各種の導電性金属材料を用いて含浸を行っても勿論構わない。

【0080】・ 2 層構造をなす実施形態のテーブル 2 に代えて、3 層構造をなすテーブルに具体化してもよい。勿論、4 層以上の積層構造にしても構わない。

・ 溝 13 は上側基材 11A のみに形成されていてもよいほか、下側基材 11B のみに形成されていてもよく、あるいは両方の基材 11A、11B に形成されていてもよい。

【0081】・ 本実施形態のテーブル 2 の使用にあたって、水路 12 内に水以外の液体を循環させてもよく、さらには気体を循環させてもよい。

・ 本発明の炭化珪素・金属複合体は、ウェハ研磨装置におけるテーブル 2 に利用されてもよいほか、テーブル以外の部材（ウェハトッププレート等）に利用されても

よい。勿論、本発明は、ウェハ研磨装置用テーブル 2 等に代表される半導体製造装置の構成材料に利用されるのみにとどまらない。例えば、同複合体を電子部品搭載用基板の放熱体に利用してもよい。また、同複合体を、メカニカルシールや軸受等の耐磨耗材料、高温炉用の耐火材、熱交換器、燃焼管等の耐熱構造材料、ポンプ部品等の耐腐食材料などに利用することも勿論可能である。

【0082】次に、特許請求の範囲に記載された技術的思想のほかに、前述した実施形態によって把握される技術的思想をその効果とともに以下に列举する。

(1) 請求項 6、7 において、前記混合物を所定形状に成形して成形体を得る工程を実施するとき、成形圧力を  $1.0 \text{ t/cm}^2 \sim 1.5 \text{ t/cm}^2$  に設定すること。従って、この技術的思想 1 に記載の発明によれば、設備コストの高騰や製造の困難化を回避しつつ、十分に熱伝導性を向上させることができる。

【0083】(2) 請求項 6、7、技術的思想 1 において、前記混合物から顆粒を作製し、それを所定形状に成形して前記成形体を得るにあたり、前記顆粒の水分率を 0.1 重量%～2.0 重量%に設定すること。従って、この技術的思想 2 に記載の発明によれば、歩留まりの悪化を回避しつつ、十分に熱伝導性を向上させることができる。

【0084】

【発明の効果】以上詳述したように、請求項 1～5 に記載の発明によれば、均熱性、熱応答性及び形状安定性に極めて優れた炭化珪素・金属複合体を提供することができる。

【0085】請求項 6、7 に記載の発明によれば、このような好適な複合体を確実に製造できる方法を提供することができる。請求項 8 に記載の発明によれば、大口径・高品質ウェハの製造に好適なウェハ研磨装置用部材を提供することができる。

【0086】請求項 9 に記載の発明によれば、大口径・高品質ウェハの製造に好適なウェハ研磨装置用テーブルを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明を具体化した一実施形態におけるウェハ研磨装置を示す概略図。

【図 2】ウェハ研磨装置に用いられるテーブルの要部拡大断面図。

【図 3】前記テーブルをさらに拡大して概念的に示した断面図。

【図 4】(a)、(b)、(c) は前記テーブルを構成する炭化珪素・金属複合体における粒度分布を示すグラフ。

【符号の説明】

1…ウェハ研磨装置、2…セラミックス構造体の一種であるウェハ研磨装置用テーブル、2a…研磨面、5…半導体ウェハ、6…ウェハ保持プレート、6a…保持面、11A、11B…基材、12…流体流路としての冷却用

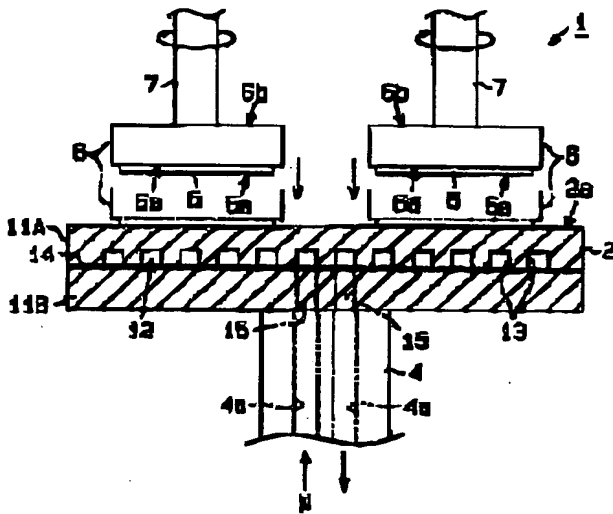
17

18

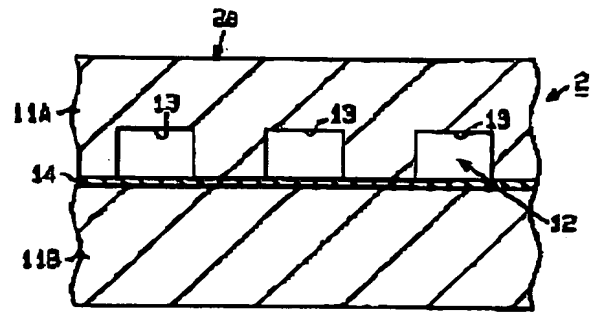
水路、21…細かい炭化珪素結晶、22…粗い炭化珪素

結晶、23…開放気孔。

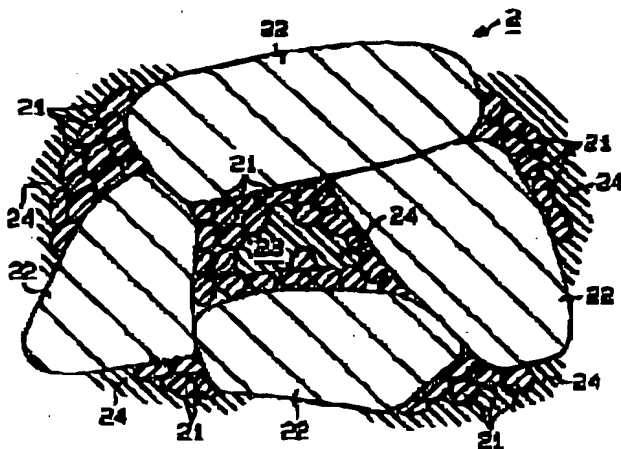
【図1】



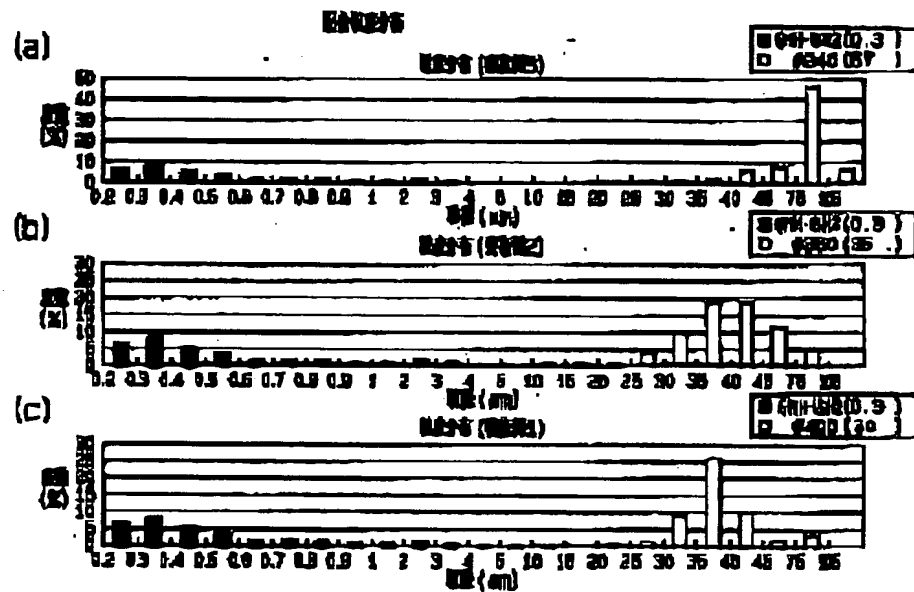
【図2】



【図3】



【図 4】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>

H 0 1 L 21/304

識別記号

6 2.2

F I

C 0 4 B 35/56

キーワード (参考)

1 0 1 P

F ターム (参考) 3C058 AA07 BC02 CB01 CB03 DA02

DA17

4G001 BA22 BA61 BA62 BA63 BA75

BA78 BB22 BB61 BB62 BB63

BC12 BC13 BC17 BC32 BC33

BC52 BC54 BC73 BC77 BD03

BD38 BE22 BE33